

연수 제안서

연구 분야	화합물 반도체 에피 성장 혹은 광소자 제작
연구 과제명	고투시성 이미징용 초격자 반도체 소재 기술
연수 제안 업무	III-V 화합물 반도체 성장, 반도체 광원 및 디텍터등의 광소자 제작
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2020년 8월 ~ 2021년 7월</p> <p>- 연수 내용 :</p> <p># 채용 분야 III-V 화합물 반도체 소재 성장, 반도체 광원 및 디텍터 등 광소자 제작</p> <p>#직무내용 중적외선 광원 혹은 디텍터 소재/소자 제작</p> <p>- MBE를 이용한 III-V 화합물 반도체 초격자 소재 성장</p> <p>- 중적외선 레이저 광원(QCL)의 제작 및 성능 개선을 위한 공정 기술 개발</p> <p>- 중적외선 디텍터(T2SL)의 제작 및 성능 개선을 위한 공정 기술 개발</p> <p>#지원 자격 박사학위 소지자</p> <p># 전공 물리/전자/재료</p>	
<p>소속 부 서 : 나노포토닉스연구센터</p> <p>연수 책임자 : 한 일 기</p>	